

# SOT223 NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER DARLINGTON TRANSISTOR

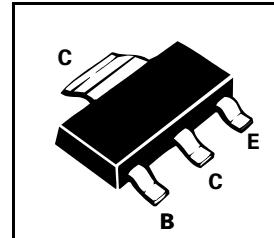
FZT600

ISSUE 3 – FEBRUARY 1997

## FEATURES

- \* 2A continuous current
- \* 140 VOLT  $V_{CEO}$
- \* Guaranteed  $h_{FE}$  Specified up to 1A

PART MARKING DETAIL – FZT600



## ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	160	V
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	140	V
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	10	V
Peak Pulse Current	$I_{CM}$	4	A
Continuous Collector Current	$I_C$	2	A
Power Dissipation	$P_{tot}$	2	W
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	°C

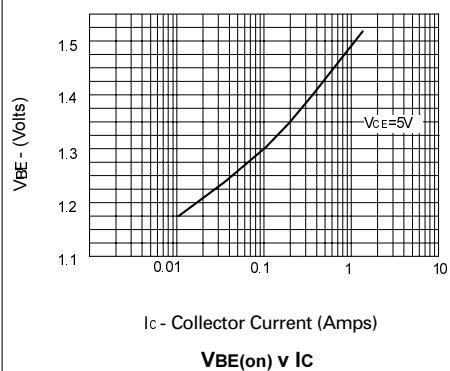
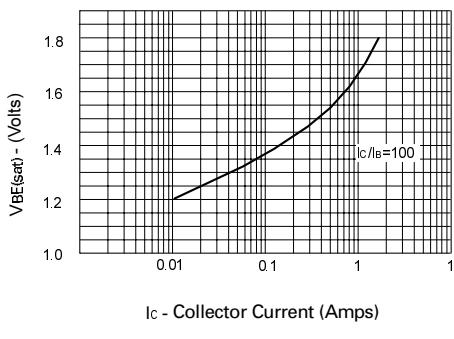
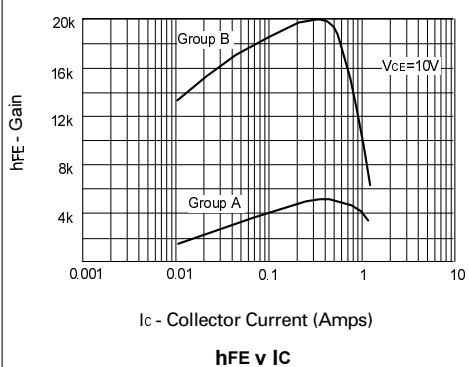
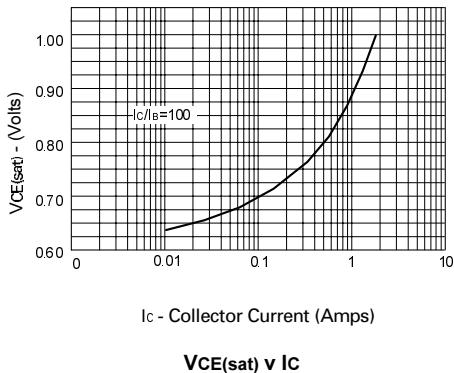
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at  $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	160			V	$I_C=100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	140			V	$I_C=10\text{mA}^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	10			V	$I_E=100\mu\text{A}$
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$			0.01 10	$\mu\text{A}$	$V_{CB}=140\text{V}$ $V_{CE}=140\text{V}, T_{amb}=100^\circ\text{C}$
Collector Cut-Off Current	$I_{CES}$			10	$\mu\text{A}$	$V_{CES}=140\text{V}$
Emitter Cut-Off Current	$I_{EBO}$			0.1	$\mu\text{A}$	$V_{EB}=8\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		0.75 0.85	1.1 1.2	V	$I_C=0.5\text{A}, I_B=5\text{mA}^*$ $I_C=1\text{A}, I_B=10\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		1.7	1.9	V	$I_C=1\text{A}, I_B=10\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		1.5	1.7	V	$I_C=1\text{A}, V_{CE}=5\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	$h_{FE}$	1k 2k 1k		100k		$I_C=50\text{mA}, V_{CE}=10\text{V}^*$ $I_C=0.5\text{A}, V_{CE}=10\text{V}^*$ $I_C=1\text{A}, V_{CE}=10\text{V}^*$
GROUP B		5k 10k 5k	10k 20k 10k	100k		$I_C=50\text{mA}, V_{CE}=10\text{V}^*$ $I_C=0.5\text{mA}, V_{CE}=10\text{V}^*$ $I_C=1\text{A}, V_{CE}=10\text{V}^*$
Transition Frequency	$f_T$	150	250		MHz	$I_C=100\text{mA}, V_{CE}=10\text{V}$ $f=20\text{MHz}$
Output Capacitance	$C_{obo}$		10	15	MHz	$V_{CB}=10\text{V}, f=1\text{MHz}$
Switching Times	$T_{on}$		0.75		$\mu\text{s}$	$I_C=0.5\text{A}, V_{CE}=10\text{V}$
	$T_{off}$		2.20		$\mu\text{s}$	$I_B=I_{B2}=0.5\text{mA}$

\*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300μs. Duty cycle ≤2%  
Spice parameter data is available upon request for this device

# FZT600

## TYPICAL CHARACTERISTICS



**Данный компонент на территории Российской Федерации****Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибуторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р В 0015-002 и ЭС РД 009

**Офис по работе с юридическими лицами:**

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru  
moschip.ru\_4

moschip.ru\_6  
moschip.ru\_9